

Содержание

Предисловие редактора	5
1. Теория образования зародышей при осаждении на подложках. <i>Хирс Дж. П., Хруска С. Дж., Наунд Г. М.</i>	15
2. Образование зародышей в ориентированных пленках. <i>Родин Т. Н., Уолтон Д.</i>	44
3. Рост ориентированных пленок на аморфных поверхностях. <i>Бауэр Е.</i>	58
4. Рентгеновское исследование структуры медных пленок, полученных испарением в высоком вакууме. <i>Вук Р. В., Шёнинг Ф., Р. Л., Витт Ф.</i>	91
5. Ориентированный рост тонких пленок теллурида серебра. <i>Папародитис К.</i>	104
6. Эффекты ориентации в пленках соединений и сплавов, полученных методом катодного распыления. <i>Франкомб М. Х., Хан И. Х., Флуд Дж. Дж., Шлактер М. М.</i>	118
7. Параметры катодного распыления, определяющие эпитаксиальный рост полупроводниковых монокристаллических пленок. <i>Крикориан Е.</i>	145
8. Изучение роста кристаллов в германневых пленках. <i>Полер Т. О., Гильберт Дж. Б.</i>	164
9. Несоответствие кристаллических решеток и силы связи на поверхности раздела между ориентированными пленками и подложками. <i>Ван-дер-Мерве Дж. Х.</i>	172
10. Наблюдение дислокаций несоответствия в сплавах золото — палладий с небольшим различием состава. <i>Мэттьюз Дж. В.</i>	202
11. Движение дислокаций поверхности раздела в процессе диффузии. <i>Хирс Дж. П.</i>	211

12. Теория азимутального расположения при эпитаксии. <i>Беттман М.</i>	215
13. Электронно-оптическое исследование эпитаксиального роста. <i>Хонд-жо Г.</i>	229
14. Новые исследования роста и структуры тонких пленок. <i>Селла К., Трияа Ж. Ж.</i>	242
15. Наблюдение дислокаций поверхности раздела при эпитаксиальном росте бромида никеля на тонких кристаллах бромида хрома. <i>Грюнбаум Е., Митчелл Дж. В.</i>	262
16. Эпитаксиальное осаждение методом дискретного испарения. <i>Ричардс Дж. Л., Гарт Н. Б., Мюллер Е. К.</i>	273
17. Рост и дефекты в эпитаксиальных пленках кремния, осаждаемых на подложки с различной ориентацией. <i>Мендельсон С.</i>	282
18. Рост монокристаллических слоев арсенида галлия на германиевых подложках. <i>Амик Дж. А.</i>	320
19. Влияние температуры и конфигурации подложки на эпитаксиальный рост германиевых пленок. <i>Шалла Р. Л., Тайдесвелл Н. В., Коффин Ф. Д.</i>	341
20. Нестандартный пример эпитаксиального роста. <i>Пелон А., Фёгели О.</i>	357
21. Применение метода эпитаксиальных пленок для изучения электронной структуры некоторых сплавов. <i>Сато Х.</i>	371
Указатель авторов	392
Предметный указатель	394

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ

Редактор В. С. Хангулова, Художник А. Шиловская

Художественный редактор Н. А. Фильчагина. Технический редактор М. П. Грибова
Корректор В. П. Киселева

Сдано в производство 14/V 1966 г. Подписано к печати 5/IX 1966 г.
Бумага 60×901/16=12,5 бум. л. 25 усл. л. Уч-изд. л. 23,23. Изд. № 20/3437
Цена 1 р. 88 к. Зак. 268
(Темпилан 1966 г. изд-ва «МИР», пор. № 218)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «М И Р»
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Московская типография № 16 Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР. Москва, Трехпрудный пер., 9